

≈ 0.29 (состав вблизи $p-n$ -перехода в экспериментальных образцах) составляют $36 \div 91$ мэВ.

Таким образом, в результате работы показано: 1) для повышения температурной стабильности S -диодов на основе $Al_xGa_{1-x}As$ целесообразно использовать варизонные структуры с тормозящими градиентами ширины запрещенной зоны; 2) немонотонность температурных характеристик тока и напряжения переключения варизонных S -диодов на основе $Al_xGa_{1-x}As$ с тянущим градиентом E_g можно связать с координатной зависимостью энергетического положения доноров относительно дна зоны проводимости.

Авторы выражают благодарность Н. З. Дерикоту, А. В. Буянову и В. Н. Ткаченко за помощь в измерении параметров материала исследованных структур и проведении эксперимента.

Список литературы

- [1] Пека Г. П., Россохатый В. К., Смоляр А. Н. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 5. С. 803—809.
- [2] Shockly W., Read W. T. // Phys. Rev. 1952. V. 87. P. 835.
- [3] Сондаевский В. П., Стафеев В. И. // ФТТ. 1964. Т. 6. В. 1. С. 80—91.
- [4] Апхинази Г. А., Киви Ё. М., Тимофеев В. Н. // ФТП. 1981. Т. 15. В. 4. С. 718—723
- [5] Bhattacharya P. K., Das U., Ludowise M. J. // Phys. Rev. B. 1984. V. 29. N 10. P. 6623—6631.
- [6] Saxena A. K., Adams A. R. // J. Appl. Phys. 1985. V. 58. N 7. P. 2640—2645.
- [7] Masu K., Tokumitsu E., Konagai M., Takahashi K. // J. Appl. Phys. 1983. V. 54. N 10. P. 5785—5792.
- [8] Adachi S. // J. Appl. Phys. 1985. V. 58. N 3. P. R1—R29.
- [9] Saxena A. K. // Phys. St. Sol. (b). 1981. V. 105. N 2. P. 777—787.

Киевский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко

Получено 8.01.1990
Принято к печати 13.04.1990

ФТП, том 24, вып. 8, 1990

ИСПРАВЛЕНИЯ К СТАТЬЕ «СПЕКТРАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ФОТОПРОВОДИМОСТИ ВЫСОКООМНОГО ZnSe»

(ФТП, 1989. Т. 23. В. 11, С. 2090—2093)

Горя О. С., Ковалев Л. Е., Коротков В. А., Маликова Л. В.,
Симацкевич А. В.

По вине авторов в статье допущены некоторые неточности [в тексте и в формулах (2) и (3)].

На стр. 2091 (7-я строка сверху) следует читать: «Спад фототока от своего максимального значения I_m до стационарного $I_{ст}$, соответствующего стационарному значению при освещении светом той же длины волны, но без предварительного возбуждения, происходит за время 10^2 — 10^8 с при $T=100$ К и за 10^1 — 10^2 с при $T=300$ К для различных образцов».

На стр. 2092 формулу (2) следует читать

$$\frac{dm_s}{dt} + \frac{1}{\tau_2} \frac{m_s^2}{m_s \text{ ст}} - \frac{m_s}{\tau_2} \left(\frac{m_s \text{ ст}}{m_s \text{ max}} + e^{-t/\tau_1} \right) = 0.$$

На стр. 2092 формулу (3) следует читать

$$m_s = \frac{m_s \text{ max} m_s \text{ ст} \exp \left[\frac{m_s \text{ ст}}{m_s \text{ max}} \frac{t}{\tau_2} + \frac{\tau_1}{\tau_2} (1 - e^{-t/\tau_1}) \right]}{m_s \text{ ст} + m_s \text{ max} \exp(\tau_1/\tau_2) [\exp(m_s \text{ ст} t / m_s \text{ max} \tau_2) - 1]}.$$

Молдавский
государственный университет
им. Я. И. Ленина
Кишинев

Получено 23.04.1990